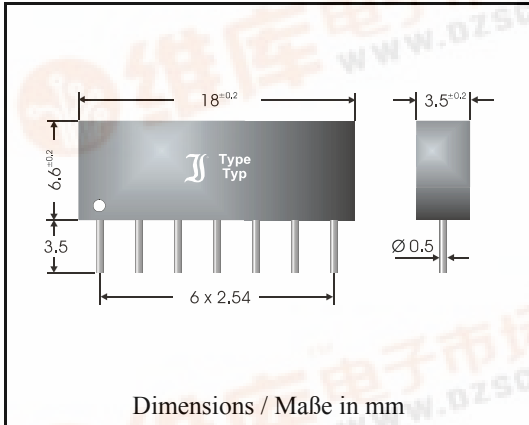


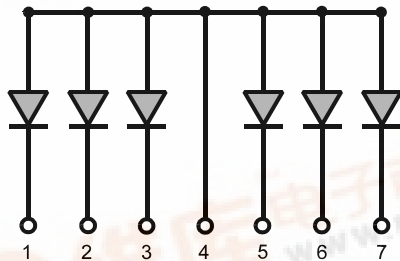
DAN 601 / DAP 601 (200 mW)

Small Diode Arrays

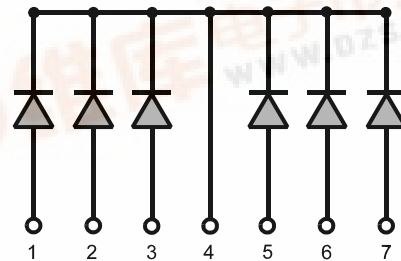
Dioden Sätze mit Allzweckdioden



Nominal power dissipation Nenn-Verlustleistung	200 mW
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	80 V
7 Pin-Plastic case 7 Pin-Kunststoffgehäuse	18 x 3.5 x 6.6 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	0.6 g
Standard packaging: bulk	see page 22
Standard Lieferform: lose im Karton	s. Seite 22



"DAP": common anodes / gemeinsame Anoden



"DAN": common cathodes / gemeinsame Kathoden

Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
DAN 601	80	80
DAP 601	80	80

Max. average forward rectified current, R-load,
for one diode operation only
per diode for simultaneous operation

$T_A = 25^\circ\text{C}$

I_{FAV} 100 mA ¹⁾
 I_{FAV} 33 mA ¹⁾

Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last,
für eine einzelne Diode
pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb

$T_U = 25^\circ\text{C}$

I_{FAV} 100 mA ¹⁾
 I_{FAV} 33 mA ¹⁾

Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwell

$T_A = 25^\circ\text{C}$

I_{FSM} 500 mA



¹⁾ valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur	T_j	- 50...+150 °C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_s	- 50...+150 °C

Characteristics		Kennwerte		
Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 10\text{ mA}$	V_F	< 1.0 V ¹⁾
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 20\text{ V}$	I_R	< 25 nA
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 10\text{ mA}$ through/über $I_R = 10\text{ mA}$ to/auf $I_R = 1\text{ mA}$		t_{rr}	< 4 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 85 K/W ²⁾

¹⁾ Valid per diode – Gültig pro Diode

²⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten